# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2003年11月26日

出 願 番 号 Application Number: 特願2003-394883

[ST. 10/C]:

[JP2003-394883]

出 願 人
Applicant(s):

セントラル硝子株式会社

REC'D 0 2 DEC 2004

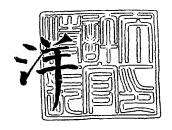
WIPO

PCT

PRIORITY DOCUMENT SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2004年10月19日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office ふ 四



BEST AVAILABLE COPY

特許願 【書類名】 03S1054 【整理番号】

平成15年11月26日 【提出日】 特許庁長官殿 【あて先】 CO1B 33/00 【国際特許分類】

【発明者】

山口県宇部市大字沖宇部5253番地 セントラル硝子株式会社 【住所又は居所】

化学研究所内

小川 毅 【氏名】

【発明者】

山口県宇部市大字沖宇部5253番地 セントラル硝子株式会社 【住所又は居所】

化学研究所内 村松 善弘

【氏名】 【発明者】

山口県宇部市大字沖宇部5253番地 セントラル硝子株式会社 【住所又は居所】

化学研究所内

大橋 満也 【氏名】

【特許出願人】

000002200 【識別番号】

セントラル硝子株式会社 【氏名又は名称】

【代理人】

100108671 【識別番号】

【弁理士】

西 義之 【氏名又は名称】

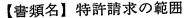
【手数料の表示】

013837 【予納台帳番号】 21,000円 【納付金額】

【提出物件の目録】

特許請求の範囲 1 【物件名】

明細書 1 【物件名】 要約書 1 【物件名】 0012122 【包括委任状番号】



# 【請求項1】

# 一般式(1)

 $S i X_n R_4 - n \cdots (1)$ 

(ただし、Xはハロゲンあるいはアルコキシド、nは1~3の整数、Rはアルキル基ある いはアリール基を表す)

で表されるオルガノシランを還元し、対応する一般式(2)

 $S i H_n R_4 - n \cdot \cdot \cdot \cdot (2)$ 

(ただし、nは1~3の整数、Rはアルキル基あるいはアリール基を表す) で表されるオルガノシランを製造する製造方法であって、反応溶媒として芳香族炭化水素 系有機溶媒を用い、水素化剤として水素化アルミニウムリチウムを用いることを特徴とす るオルガノシランの製造方法。

# 【請求項2】

反応温度が40~120℃であることを特徴とする請求項1記載のオルガノシランの製造 方法。

# 【請求項3】

有機溶媒中にA1C14 イオンを放出する物質を触媒として使用することを特徴とする 請求項1、2いずれかに記載のオルガノシランの製造方法。

# 【請求項4】

触媒がLiAlCl4であることを特徴とする請求項3記載のオルガノシランの製造方法

# 【書類名】明細書

【発明の名称】オルガノシランの製造方法

# 【技術分野】

# [0001]

本発明は、半導体製造における成膜原料、あるいは有機合成に有用なオルガノシランの 製造法に関するものである。

#### 【背景技術】

# [0002]

オルガノシラン、特に、メチルシラン (СН3 ЅіН3)、トリメチルシラン ((СН 3)3 SiH)は、半導体デバイス製造におけるCVD成膜材料として有用な材料ガスで あり、特に近年では低誘電率絶縁膜の材料ガスとして注目されている。オルガノシランを 製造する方法は、ジエチルエーテル (C2 H5 OC2 H5) やジメトキシエタン (DME )、ジグリム(DGM)、テトラヒドロフラン (THF) といった極性有機溶媒中で水素化 アルミニウムリチウム(LiAlH4)等の還元剤を使用する方法が一般的であり、生成 物の純度、収率も優れている。従来、LiAlH₄ による還元反応は、極性溶媒中でのみ 生じ、ヘキサン、ヘプタンのような極性のない炭化水素系溶媒では、反応が生じないとさ れており、オルガノシランの反応溶媒についても極性溶媒を用いた反応例以外は文献等で 開示されていない。また、本発明で使用される芳香族炭化水素系有機溶媒の一つであるト ルエン溶媒中において、シクロヘキサノンのLiAlH4 還元が試みられているが、還元 により得られるはずのシクロヘキサノールは確認されていない(非特許文献1)。一般に LiAlH4 還元は、有機溶媒中にAlH4 イオンが解離生成して、これが反応物質に 作用して反応が生じると考えられている。したがって、LiAlH4を溶解できる極性溶 媒でのみ反応が進行し、トルエンのように極性のほとんどない溶媒中では、LiAlH4 を溶解できないため反応が生じないと考えられている。

# [0003]

極性溶媒を用いたオルガノシランの合成例としては、例えば、DME溶媒を用いてトリメチルクロロシラン((CH3)3 SiCl)とLiAlH4 とを還流下86  $\mathbb C$ の温度で反応させることにより(CH3)3 SiHを85%の収率で合成する方法が記載されている(非特許文献2)。また、DGM溶媒を用いてエトキシトリメチルシラン((CH3)3 SiOC2 H5)とLiAlH4 とを50~70  $\mathbb C$ の温度で反応させることにより(CH3)3 SiHを91%の収率で合成する方法が記載されている(特許文献1)。

## [0004]

しかしながらこれら極性溶媒を用いる方法では、反応終了後の残液中に溶媒和したオルガノシランが残存してしまい、その回収が困難であることから収率の低下を招いた。また、反応残液を処理する場合、ジエチルエーテル以外の溶媒は全て水溶性であり、水で処理すると溶媒の回収が困難であった。反応残液から溶媒を蒸発回収する方法を用いた場合においても、溶媒の極性が高いため残渣との分離が困難であり、溶媒の回収利用が極めて困難であった。

【特許文献1】WO 01/58908号公報

【非特許文献1】 J. Chem. Res. (S), 1, 24 (1990)

【非特許文献 2】 J. Amer. Chem. Soc., 83, 1916 (1961)

# 【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

## [0005]

本発明は、従来の極性溶媒が持つ問題点を解消し、高純度なオルガノシランを高収率で 生産性良く製造する方法を提供することを目的としている。

# 【課題を解決するための手段】

# [0006]

本発明者らは、上記目的を達成するため、鋭意検討を重ねた結果、原料であるオルガノ ハロシラン等とLiAlH4とを微極性溶媒である芳香族炭化水素系溶媒中で40~12

0 ℃の条件で反応させることによりオルガノシランを製造できることを見出し本発明に至 ったものである。また、この場合、副生するLiAlCl4 が触媒となる自触媒反応であ ること見出し、特に反応開始時にLiAlCl4を添加しておくことで、初期の反応速度 が飛躍的に大きくなり、安全かつ安定にオルガノシランを製造することができることを見 出した。

# [0007]

すなわち、本発明は、一般式(1)

 $S i X_n R_4 - n \cdots (1)$ 

(ただし、Xはハロゲンあるいはアルコキシド、nは1~3の整数、Rはアルキル基ある いはアリール基を表す)

で表されるオルガノシランを還元し、対応する一般式(2)

 $SiH_nR_{4-n}$  · · · · (2)

(ただし、nは1~3の整数、Rはアルキル基あるいはアリール基を表す)

で表されるオルガノシランを製造する製造方法であって、反応溶媒として芳香族炭化水 素系有機溶媒を用い、水素化剤として水素化アルミニウムリチウムを用いることを特徴と するオルガノシランの製造方法を提供するものである。

# [0008]

本発明によれば、水に不溶な微極性溶媒を用いるために、反応残液を水洗、分液処理す ることにより容易に溶媒を回収することができる。また、極性がほとんどないために反応 で生成したオルガノシランをほとんど全量回収することができ、非常に高収率に製造可能 となる。更には、芳香族炭化水素は、一般に沸点が高いため、生成するオルガノシラン中 に同伴される溶媒量も少なく、半導体成膜材料ガスとして使用する場合に要求される超高 純度も比較的容易に達成できる。

# 【発明の効果】

# [0009]

本発明の方法によれば、反応に使用した溶媒を容易に回収でき、高純度なオルガノシラ ンを高収率で生産性良く製造できる。

【発明を実施するための最良の形態】

以下、本発明を更に詳述する。本発明で原料に使用するオルガノハロシラン等としては 、一般式(1)

 $S i X_n R_{4-n} \cdot \cdot \cdot \cdot (1)$ 

(ただし、Xはハロゲンあるいはアルコキシド、nは1~3の整数、Rはアルキル基あ るいはアリール基を表す)

で表されるものである。Rとしては、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロ ピル基等のアルキル基、及びアリール基であり、Rが複数存在する場合には、これらが互 いに同一のものでも異なったものが混在したものでも良い。Xとしては、例えばフルオロ 基、クロロ基、ブロモ基、ヨード基、メトキシ基、エトキシ基等のものが使用できる。通 常、入手が容易で安価なクロロ基のものが好ましく使用できる。

# [0011]

使用する溶媒としては、芳香環を含む炭化水素系溶媒であればよいが、A1C14 - イ オンを解離溶解することができるものでなければならない。具体的にはベンゼン、トルエ ン、キシレン、エチルベンゼン、ブチルベンゼン、アニソールなどがあげられる。

# [0012]

本発明において、反応を円滑に進行させるためには、触媒の添加が不可欠である。すな わち、極性の乏しい芳香族炭化水素系溶媒においては、触媒が存在しない場合には、L i AlH4の還元力が低く、反応が極めて遅い。触媒としては、AlCl4 イオンを放出 する物質であれば特に限定されない。具体的には、LiAlCl4 、NaAlCl4 、K A 1 C 1 4 等が挙げられるが、L i A 1 C 1 4 が特に好ましい。原料のオルガノハロシラ ン等に塩化物を使用する場合には、反応の進行とともにLiA1Cl4 を副生するため、

自触媒反応となる。このため、無触媒で反応させると反応初期には反応速度が遅く、反応の進行とともに反応速度が飛躍的に増大する。その結果、原料の塩化物の導入速度が速い場合には、しばしば反応が一気に生じて暴走するので極めて危険である。LiAlH4の反応触媒としては、AICl3が有名であるが、本発明においてはほとんど触媒として働かない。

# [0013]

触媒には、LiA1C14 そのものを用いても良いが、入手が容易なLiC1EA1C13 との1:1混合物を用いても良い。また、原料に塩化物を使用する場合には、反応残液で生成したLiA1C14 の一部を再利用することも可能である。触媒添加量は、溶媒への溶解度以上仕込むことが好ましい。例えば、トルエンを溶媒として用いる場合には、0.02g/m1以上添加することが好ましい。

# [0014]

本発明において、反応温度は40  $\mathbb{C}$   $\sim$  120  $\mathbb{C}$  、好ましくは60  $\sim$  100  $\mathbb{C}$  で反応を行う。40  $\mathbb{C}$  未満では還元能力が低く反応が非常に遅くなり、120  $\mathbb{C}$  超では、 $\mathbb{L}$  i Al H 4 の分解反応が生じて危険である。

# [0015]

反応終了後は反応器を加温あるいは減圧とすることで、溶媒中に溶解したオルガノシランを回収することができる。溶解したオルガノシランは溶媒和を受けないため、溶存しているオルガノシランの全量が回収可能である。原料に塩化物を使用する場合には、反応残液は直ちに溶媒層と $LiAlCl_4$ の残渣層との2層に分離するため、分液することで残渣と溶媒を容易に分離することが可能である。回収した溶媒中には $LiAlCl_4$ が溶解しているため、これを再び反応に使用することにより触媒を新たに添加する必要がなくなる。

# [0016]

また、残液の処理は、塩酸洗浄や水洗浄を行い分液することで純粋な溶媒を容易に回収することが可能である。

#### 【実施例】

# [0017]

以下、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明は下記実施例に制限されるものではない。

#### [0018]

#### 実施例1

還流器を備えた500m1-ガラス製フラスコをヘリウムガスで置換した。フラスコに 1.16g(0.031mo1)のLiAlH4と30m1のトルエンを入れて攪拌し、80℃に昇温後、14m1(0.110mo1)の(CH3)3SiClを10minで滴下した。滴下直後のガス発生はほとんど無かったが、滴下とともに徐々にガス発生が生じ、1/3滴下した点で急激な発泡が観察された。発生したガスは、還流器を通し、液体窒素で冷却されたトラップに全量捕集して重量を測定した。また、捕集ガスをガスクロマトグラフ分析計、ガスクロマトグラフー質量分析計により同定、定量した。得られたガスは、(CH3)3SiHであり、純度96.9vol%、収率92.5%であった。

# [0019]

#### 実施例2

フラスコに $LiAlH_4$  とともに0.6g(0.004mol)の $LiAlCl_4$  を触媒として添加する以外は実施例1と同様の方法で反応させた。 $(CH_3)_3$  SiClの滴下直後からガスの発生が認められ、急激な発泡は認められず穏やかに反応が進行した。捕集ガスは、 $(CH_3)_3$  SiHであり、純度98.1 vol%、収率92.7%であった。

## [0020]

#### 実施例3

フラスコに $LiAlH_4$  とともに0.5g(0.004mol)の $AlCl_3$  と0.13g(0.003mol)のLiCl とを触媒として添加する以外は実施例1と同様の方法で



反応させた。 $(CH_3)_3$  SiClの滴下直後からガスの発生が認められ、急激な発泡は認められず穏やかに反応が進行した。捕集ガスは、 $(CH_3)_3$  SiHであり、純度 97.8 vol%、収率 94.4%であった。

# [0021]

# 実施例4

トルエンのかわりに反応残液の溶媒層の液を 30m1 使用する以外は実施例 1 と同様の方法で反応させた。 $(CH_3)_3$  S i C 1 の滴下直後からガスの発生が認められ、急激な発泡は認められず穏やかに反応が進行した。捕集ガスは、 $(CH_3)_3$  S i Hであり、純度 9 2 . 4 v o 1 %、収率 9 4 . 3 %であった。

#### [0022]

#### 実施例 5

トルエンのかわりにキシレンを 30m1 使用する以外は実施例 3 と同様の方法で反応させた。 $(CH_3)_3$  SiC1 の滴下直後からガスの発生が認められ、急激な発泡は認められず穏やかに反応が進行した。捕集ガスは、 $(CH_3)_3$  SiHであり、純度 96.3 vol 2%、収率 95.4%であった。

# [0023]

# 実施例 6

 $(CH_3)_3$  SiClのかわりにCH<sub>3</sub> SiCl<sub>3</sub>を4ml(0.037mol)滴下する以外は実施例3と同様の方法で反応させた。CH<sub>3</sub> SiCl<sub>3</sub>の滴下直後からガスの発生が認められ、急激な発泡は認められず穏やかに反応が進行した。捕集ガスは、CH<sub>3</sub> SiH<sub>3</sub>であり、純度96.8 vol%、収率93.1%であった。

# [0024]

#### 実施例7

# [0025]

#### 実施例8

反応温度を120 Cとする以外は実施例 3 と同様の方法で反応させた。 $(CH_3)_3$  Si Clの滴下直後からガスの発生が認められ、急激な発泡は認められず穏やかに反応が進行した。捕集ガスは、 $(CH_3)_3$  Si Hであり、純度 93.5 vol%、収率 78.1%であった。

# [0026]

#### 実施例 9

最初の温度を25 Cとする以外は実施例 3 と同様の方法で反応させた。 $(CH_3)_3$  Si Clの滴下終了までガス発生は、ほとんどなかった。攪拌しながら80 Cまで加温すると、5 min後 (80 C) に急激な発泡が観測されたので、発生したガスをトラップに捕集した。捕集ガスは、 $(CH_3)_3$  Si Hであり、純度93.5 vol%、収率91.1%であった。

#### [0027]

## 実施例10

還流器を備えた1.5 L-ステンレス鋼製反応器をヘリウムガスで置換した。反応器に24.85g(0.655mol)のLiAlH4、5.02g(0.038mol)のAlCl3、1.60g(0.038mol)のLiCl、および321mlのトルエンを入れて攪拌し、80℃に昇温後、300ml(2.364mol)の(CH3)3SiClを3hrで滴下した。滴下直後からガスの発生が認められ、急激な発泡は認められず穏やかに反応が進行した。捕集ガスは、(CH3)3SiHであり、純度98.0vol%、収率96.6%であった。反応後の反応残液に1%-塩酸300mlを加え、下層より水層を抜き出した。上層の有機層は、318ml得られ、純度99%以上のトルエンであった。



[0028]

比較例1

トルエンのかわりにテトラヒドロフラン (THF) を 30m1 溶媒として使用し、反応温度を室温とする以外は実施例 1 と同様の方法で反応させた。 $(CH_3)_3$  S i C 1 の滴下直後からガスの発生が認められ、急激な発泡は認められず穏やかに反応が進行した。捕集ガスは、 $(CH_3)_3$  S i Hであり、純度 7 6 . 2 v o 1 % 、収率 7 1 . 4 % であった。



# 【書類名】要約書

【要約】

【課題】 半導体製造における成膜原料、あるいは有機合成に有用なオルガノシランの製造法を提供する。

【解決手段】 一般式(1)

 $S i X_n R_4 - n \cdot \cdot \cdot \cdot (1)$ 

(ただし、Xはハロゲンあるいはアルコキシド、nは $1\sim3$ の整数、Rはアルキル基あるいはアリール基を表す)

で表されるオルガノシランを還元し、対応する一般式 (2)

 $SiH_nR_{4-n}$  · · · · (2)

(ただし、nは1~3の整数、Rはアルキル基あるいはアリール基を表す)

で表されるオルガノシランを製造する製造方法であって、反応溶媒として芳香族炭化水素系有機溶媒を用い、水素化剤として水素化アルミニウムリチウムを用いる。

【選択図】 なし

特願2003-394883

出願人履歴情報

識別番号

[000002200]

1. 変更年月日

1990年 8月24日

[変更理由]

新規登録

住 所

山口県宇部市大字沖宇部5253番地

氏 名 セントラル硝子株式会社

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS	
$\square$ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
GRAY SCALE DOCUMENTS	
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
□ other:	

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.